

特許出願の番号

特願2004-093398

起案日

平成18年 6月 6日

特許庁審査官

福島 浩司

3615 2L00

特許出願人代理人

曾我 道照 (外 4名)

適用条文

第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出して下さい。

理 由

理由1

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等・・覧参照)

- ·請求項1-4
- ・引用文献1

理由2

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用 可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- 請求項1-37
- ·引用文献 1 -- 6

備考:

請求頃1、20について、引用文献1にはゲートパッド、データパッド、共通 パッドを露出させる保護膜を具備する薄膜トランジスタアレイ基板と、カラーフ

Best Available Copy

<u>整理番号:SS36254</u> 発送番号:246522 発送日:平成18年 6月20日 2 イルタ基板を有する水平電界印加型液晶表示装置が記載されている。

なお、パッドと接続される導電性フィルムは慣用技術であり、引用文献1に記載の液晶表示装置にも備わっていると言える。

請求項2-4、21-25について、引用文献1に記載の液晶表示装置のゲートラインおよび共通ラインは、MoとITOとの積層構造であり、パッド部においてITOが露出している。

請求項5について、引用文献2には、TiとAlの積層膜で構成される電極配線を直接外部に引き出して保護膜から露出させ、電極端子とさせた液晶表示装置が記載されている。したがって、引用文献1に記載の液晶表示装置において、引用文献2に記載の配線構造を採用することにより、本顕発明のような構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。

請求項6-8、13-14、17、26-28について、引用文献3には、アルミニウム、チタン、ITOの積層構造を有するデータライン、および該データラインと同一な導電層から構成される画素電極を具備する水平電界印加型液晶表示装置が記載されている。したがって、引用文献1-3に記載の発明に基いて、本願発明のような構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。なお、請求項28に係る発明のように、パッド部のコンタクトホールが主導電層を貫く構成とすることに格別の効果は認められず、当業者が適宜なし得る設計事項に過ぎない。

請求項9、29について、請求項5についての検討と同様に、引用文献1-3 に記載の発明に基いて、本願発明のような構成とすることは、当業者が容易に想 到し得ることである。

請求項10-12、31-33について、引用文献4にはエッチング防止層を 具備した基板が記載されている。また、液晶装置の基板の全面に酸化アルミニウム (Al_2O_3) 、酸化チタン (TiO_2) を全面に形成した構成は周知である (必要であれば、引用文献5【0039】等参照)。

請求項15、30について、引用文献3には、共通ラインの一部からなるストレージ下部電極、および、画素電極と同一な導電層から構成されるストレージ上部電極を具備するストレージキャパシタが記載されている。

請求項16について、引用文献3の半導体層は、データライン、ソース電極、 ドレイン電極、画素電極、ストレージ上部電極に沿って、ゲート絶縁膜上に形成 されている。

請求項18-19、34-35について、引用文献6には、ゲート/ソース配線、TFT素子等の形成後、ソース配線横にはみ出した半導体層が、ソース配線をマスクとして除去された液晶表示装置が記載されている。したがって、引用文献1-3に記載の液晶表示装置において、画素電極フィンガー部の半導体層の整形のため、引用文献6に記載された発明を適用することにより、本願発明のような構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。

請求項36について、主導電層を貫くコンタクトホールとすることに格別の効

Best Available Copy

引用文献等一覧

- 1. 特開2002-90779号公報(特に、【0139】-【0157】、図 25-27参照)
- 2. 特開平7-169967号公報(特に、図1参照)
- 3. 特開2001-264804号公報 (特に、【0044】--【0077】、図1-6参照)
- 4. 特開平6-296023号公報
- .5. 特開平5-206468号公報
- 6. 特開2002-40479号公報 (特に、図6-7参照)

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野
- IPC第8版 G02F 1/1368
- ・先行技術文献
- 特開2003-57673号公報
- この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理山を構成するものではありません。

この拒絶理由についての問い合わせがあるとき、または、この出願についての面接を希望されるときは、以下までご連絡ください。

連絡先 : 特許審査第一部光デバイス 奥田雄介

(03-3581-1101 内線3293)